



NAME: Jabbarov Bahor Olimbayevna

POSITION: Head teacher

TEL: +99894 230 26 13

E – mail: bahorbahor1989@mail.ru

ORGANISATION TEL: +99862 2246700

ORGANISATION ADDRESS: Urgench, Kh.Olimjan str, 14, 220100

EDUCATION:	<ul style="list-style-type: none"> • 2008 – 2012 - Urgench State University (bachelor) • National University of Uzbekistan (master) in 2012-2014
CAREER / EMPLOYMENT:	<ul style="list-style-type: none"> • 2014 - 2015 Lecturer, Department of Physics, Urgench State University • 2021 - So far, a Senior Lecturer at the Department of Physics, Urgench State University
SPECIALITY	<ul style="list-style-type: none"> • Physics.
TEACHING SUBJECTS:	<ul style="list-style-type: none"> • General Physics, Molecular physics,
RESEARCH AREAS OF INTEREST:	<ul style="list-style-type: none"> • Modeling the effect of technological fluctuations on the self-heating effect of junctionless transition nanoscale field-effect transistors
PRESENT PROJECTS:	<ul style="list-style-type: none"> • M.M Khalilloev, B. O. Jabbarova A. A. Nasirov The Influence of Fin Shape on the Amplitude of Random Telegraph Noise in the Subthreshold Regime of a Junctionless FinFET //Technical Physics Letters, 2019, Vol. 45, No. 12, pp. 1245–1248. • Халиллоев М.М., А.Э. Абдикаримов, З. Атамуратова, Б. Жаббарова, А.Э. Атамуратов. Короткоканальные эффекты в безпереходном МОП-транзисторе с различным уровнем легирования и формой базы//Республиканской научно-практической конференции участием зарубежных ученых «Инновационные технологии в науке и образовании». - Нукус. 20-21 ноября, 2018. - С. 106-107. • Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Влияние формы канального слоя и бокового расширения затвора на пороговое напряжение в безпереходном МОП-транзисторе //Материалы международной конференции «Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниковых микро- и наноструктурах». - Фергана. 25-26 мая, 2018.- С. 295-296 • Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Сравнение амплитуды случайных телеграфных шумов в МОП транзисторах без переходов и с инверсионным каналом//«Современные проблемы физики

	полупроводников» СПФП-2019 –Нукус 20 ноября 2019 г. 82-86
LIST OF SELECTED PAPERS	<ul style="list-style-type: none">• A.E.Atamuratov, B.O. Jabbarova, M.M. Khalilloev, A. Yusupov, A.G.J.Loureiro Self-heating effect in nanoscale SOI Junctionless FinFET with different geometries// 13th Spanish Conference on Electron Devices